

ISD4003 系列高保真语音录放 IC

单片 4 至 8 分钟语音录放, 4、5、6 及 8 分钟	无需开发系统
内置微控制器串行通信接口	3V 单电源工作
多段信息处理	工作电流 25-30mA, 维持电流 1 μ A
不耗电信息保存 100 年(典型值)	高质量、自然的语音还原技术
100,000 次录音周期(典型值)	自动静噪功能
片内免调整时钟, 可选用外部时钟	

4003 系列型号与性能对照表

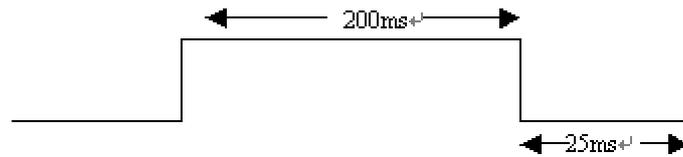
型 号	时 间	输入采样	典型带宽	最大段数	最小段长	外部钟频
ISD4003-04M	4 分钟	8.0kHz	3.4kHz	1200	200ms	1024.0kHz
ISD4003-05M	5 分钟	6.4kHz	2.7kHz	1200	250ms	819.2kHz
ISD4003-06M	6 分钟	5.3kHz	2.3kHz	1200	300ms	682.7kHz
ISD4003-08M	8 分钟	4.0kHz	1.7kHz	1200	400ms	512.0kHz

ISD4003 系列工作电压 3V, 单片录放时间 4 至 8 分钟, 音质好, 适用于移动电话及其他便携式电子产品中。芯片采用 CMOS 技术, 内含振荡器、防混淆滤波器、平滑滤波器、音频放大器、自动静噪及高密度多电平闪烁存储阵列。芯片设计是基于所有操作必须由微控制器控制, 操作命令可通过串行通信接口(SPI 或 Microwire)送入。芯片采用多电平直接模拟量存储技术, 每个采样值直接存贮在片内闪烁存储器中, 因此能够非常真实、自然地再现语音、音乐、音调 and 效果声, 避免了一般固体录音电路因量化和压缩造成的量化噪声和“金属声”。采样频率可为 4.0, 5.3, 6.4, 8.0kHz, 频率越低, 录放时间越长, 而音质有所下降, 片内信息存于闪烁存储器中, 可在断电情况下保存 100 年(典型值), 反复录音 10 万次。

二、引脚描述

电源:(VCCA, VCCD) 为使噪声最小, 芯片的模拟和数字电路使用不同的电源总线, 并且分别引到外封装的不同管脚上, 模拟和数字电源端最好分别走线, 尽可能在靠近供电端处相连, 而去耦电容应尽量靠近器件。

地线:(VSSA, VSSD) 芯片内部的模拟和数字电路也使用不同的地线。几个 VSSA 尽量在引脚焊盘上相连, 并用低阻通路连至电源上, VSSD 也用低阻通路连至电源上。这些接地通路要足以使 VSSA 与 VSSD 之间的阻值小于 3 Ω 。芯片的背面是通过衬底电阻连接到 VSS 的, 在做 COB 时托盘须接 VSS 或悬空。



外部时钟 (XCLK): 本端内部有下拉元件。芯片内部的采样时钟在出厂前已调校,误差在+1%内。商业级芯片在整个温度和电压范围内,频率变化在+2.25%内。工业级芯片在整个温度和电压范围内,频率变化在-6/+4%内,此时建议使用稳压电源。若要求更高精度,可从本端输入外部时钟(如前表所列)。由于内部的防混淆及平滑滤波器已设定,故上述推荐的时钟频率不应改变。输入时钟的占空比无关紧要,因内部首先进行了分频。在不外接地时钟时,此端必须接地。

自动静噪 (AMCAP): 当录音信号电平下降到内部设定的某一阈值以下时,自动静噪功能使信号衰弱,这样有助于养活无信号(静音)时的噪声。通常本端对地接 $1\mu\text{F}$ 的电容,构成内部信号电平峰值检测电路的一部分。检出的峰值电平与内部设定的阈值作比较,决定自动静噪功能的翻转点。大信号时,自动静噪电路不衰减,静音时衰减 6dB。 $1\mu\text{F}$ 的电容也影响自动静噪电路对信号幅度的响应速度。本端接 VCCA 则禁止自动静噪。

三、SPI (串行外设接口)

ISD4003 工作于 SPI 串行接口。SPI 协议是一个同步串行数据传输协议,协议假定微控制器的 SPI 移位寄存器在 SCLK 的下降沿动作,因此对 ISD4003 而言,在时钟止升沿锁存 MOSI 引脚的数据,在下降沿将数据送至 MISO 引脚。协议的具体内容为:

1. 所有串行数据传输开始于 SS 下降沿。
2. SS 在传输期间必须保持为低电平,在两条指令之间则保持为高电平。
3. 数据在时钟上升沿移入,在下降沿移出。
4. SS 变低,输入指令和地址后,ISD 才能开始录放操作。
5. 指令格式是(5 位控制码)加(11 位地址码)。
6. ISD 的任何操作(含快进)如果遇到 EOM 或 OVF,则产生一个中断,该中断状态在下一个 SPI 周期开始时被清除。
7. 使用“读”指令使中断状态位移出 ISD 的 MISO 引脚时,控制及地址数据也应同步从 MOSI 端移入。因此要注意移入的数据是否与器件当前进行的操作兼容。当然,也允许在一个 SPI 周期里,同时执行读状态和开始新的操作(即新移入的数据与器件当前的操作可以不兼容)。
8. 所有操作在运行位(RUN)置 1 时开始,置 0 时结束。
9. 所有指令都在 SS 端上升沿开始执行。

(一)信息快进

用户不必知道信息的确切地址,就能快进跳过一条信息。信息快进只用于放音模式。放音速度是正常的 1600 倍,遇到 EOM 后停止,然后内部地址计数器加 1,指向下条信息的开始处。

(二)上电顺序

器件延时 TPUD(8kHz 采样时,约为 25 毫秒)后才能开始操作。因此,用户发完上电指令后,必须等待 TPUD,才能发出一条操作指令。例如:从 00 从处发音,应遵循如下时序: 1. 发 POWER Up 命令; 2. 等待 TPUD(上电延时); 3.

发地址值为 00 的 SETPLAY 命令; 4. 发 PLAY 命令。

器件会从此 00 地址开始放音, 当出现 EOM 时, 立即中断, 停止放音。

如果从 00 从处发音, 则按以下时序:

1. 发 POWER UP 命令;
2. 等待 TPUD(上电延时);
3. 发 POWER UP 命令
4. 等待 2 倍 TPUD;
- 5 发地址值为 00 的 SETREC 命令;
6. 发 REC 命令。

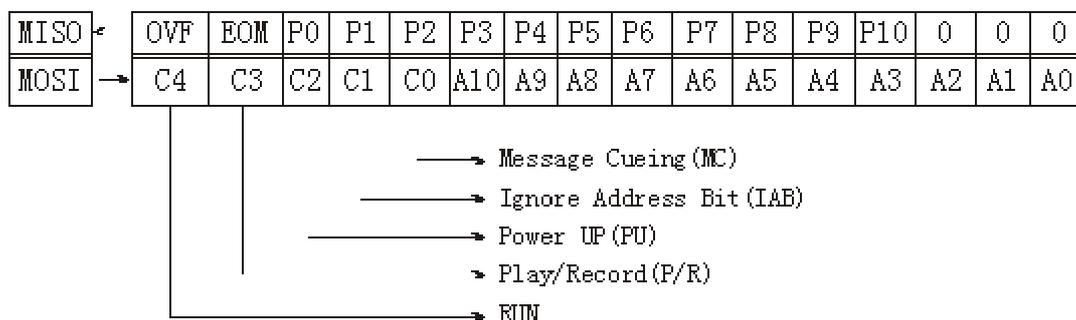
器件便从 00 地址开始录音, 一直到出现 OVF(存贮器末尾)时, 录音停止。

指令表

指令	5 位控制码<11 位地址>	操作摘要
POWERUP	00100<XXXXXXXXXXXX>	上电:等待 TPUD 后器件可以工作
SET PLAY	11100<A10-A0>	从指定地址开始放音。必须后跟 PLAY 指令使放音继续
PLAY	11110<XXXXXXXXXXXX>	从当前地址开始放音(直至 EOM 或 OVF)
SET REC	10100<A10 -A0>	从指定地址开始录音。必须后跟 REC 指令录音继续
REC	10110<XXXXXXXXXXXX>	从当前地址开始录音(直至 OVF 或停止)
SET MC	11101<A10 -A0>	从指定地址开始快进。必须后跟 MC 指令快进继续
MC	11111<XXXXXXXXXXXX>	执行快进,直到 EOM.若再无信息,则进入 OVF 状态
STOP	0X110<XXXXXXXXXXXX>	停止当前操作
STOP WRDN	0X01X<XXXXXXXXXXXX>	停止当前操作并掉电
RINT	0X110<XXXXXXXXXXXX>	读状态:OVF 和 EOM

注: 快进只能在放音操作开始时选择。

(三)SPI 端口的控制位



(四)SPI 控制寄存器

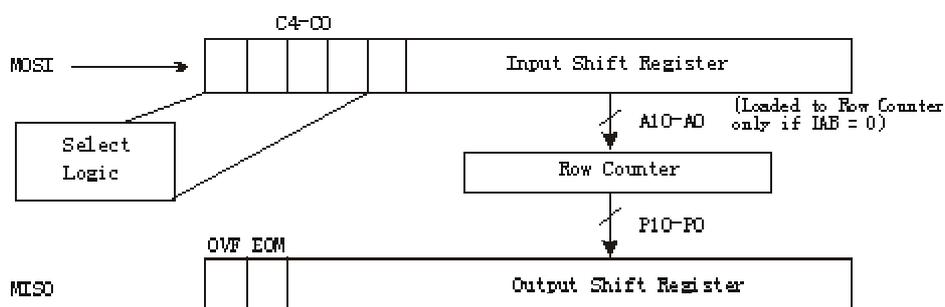
SPI 控制寄存器控制器件的每个功能,如录放、录音、信息检索(快进)、上电/掉电、开始和停止操作、忽略地址指针等。详见下表:

位	值	功能	位	值	功能
RUN	1	允许/禁止操作开始	PU	1	电源控制上电

=	1	开始	=	1	上电
=	0	停止	=	0	掉电
P/-R		录/放模式	IAB		操作是否使用指令地址
=	1	放取	=	1	忽略输入地址寄存器的内容
=	0	录	=	0	使用输入地址寄存器的内容
MC		快进模式	P9-P0		行指针寄存器输出
=	1	允许快进			输入地址寄存器
=	0	禁止	A9-A0		

注：IAB 置 0 时,录、放操作从 A9-A0 地址开始。为了能连贯地录、放到后续的存储空间,在操作到达该行末之前,应发出第二个 SPI 指令将 IAB 置 1,否则器件在同一地址上反复循环。这个特点对语音提示功能很有用。

RAC 脚和 IAB 位可用于信息管理。SPI 端口简单框图如下：



Symbol	Parameters	Min	Typ	Max	Units
TSSS	/SS Setup Time	500			nsec
TSSH	/SS Hold Time	500			nsec
TDIS	Data in Setup Time	200			nsec
TDIH	Data in Hold Time	200			nsec
TPD	Output Delay			500	nsec
TDF	Output Delay to Hiz			500	nsec
TSSmin	/SS HIGH	1			μsec
TSCKhi	SCLK High Time	400			nsec
TSCKlow	SCLK Low Time	400			nsec
F0	CLK(Frequency)			1000	kHz